









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD60R3K4CEAUMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 2.6A TO252-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPD60R3K4CEAUMA1.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPD60R3K4CEAUMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 2.6A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 40µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 Ohm @ 500mA, 10V
Verlustleistung (max)	29W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	SP001422856
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	93pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 2.6A (Tc) 29W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A (Tc)

IPD60R3K4CEAUMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD60R3K4CEAUMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD60R3K4CEAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD60R3K4CEAUMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD60R400CEATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO-252-3</p>	 <p>IPD60R385CPATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 9A TO-252</p>	 <p>IPD60R450E6 Infineon Technologies IPD60R450E6 Infineon Technologies</p>	 <p>IPD60R400CEAUMA1 Infineon Technologies CONSUMER</p>
 <p>IPD60R385CPBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 9A TO-252</p>	 <p>IPD60R3K3C6 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 1.7A TO252-3</p>	 <p>IPD60R450E6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 9.2A TO252</p>	 <p>IPD60R400CE infineon IPD60R400CE infineon</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD60R3K4CEAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD60R3K4CEAUMA1 Datenblatt	IPD60R3K4CEAUMA1-Datenblätter	IPD60R3K4CEAUMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD60R3K4CEAUMA1
IPD60R3K4CEAUMA1 Electronic	IPD60R3K4CEAUMA1-Komponenten	IPD60R3K4CEAUMA1-Verteiler	IPD60R3K4CEAUMA1-Bild	IPD60R3K4CEAUMA1-Teil
IPD60R3K4CEAUMA1 Preis	IPD60R3K4CEAUMA1 Hersteller	IPD60R3K4CEAUMA1 Bild	IPD60R3K4CEAUMA1 Aktie	IPD60R3K4CEAUMA1 Inventar
IPD60R3K4CEAUMA1 Neu	IPD60R3K4CEAUMA1 Original	IPD60R3K4CEAUMA1 garantiert	IPD60R3K4CEAUMA1 RFQ	IPD60R3K4CEAUMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited